

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0224U002739

Державний реєстраційний номер: 0121U108529

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-02-2024

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Створення базових технологій формування напівпровідникових матеріалів і структур для нано- та оптоелектроніки

Початок етапу: 01.2021

Закінчення етапу: 12.2023

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: проспект Науки, буд. 41, м. Київ, 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020, 380445258342

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442343243

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 654 1030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 49376.771
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Створення базових технологій формування напівпровідникових матеріалів і структур для нано- та оптоелектроніки

Назва роботи англійською:

Creation of basic technologies for the formation of semiconductor materials and structures for Nano - and optoelectronics

Реферат українською:

Робота була спрямована на проведення прикладних досліджень з метою вирішення актуальних проблем сучасного напівпровідникового матеріалознавства, а саме для виготовлення та дослідження експериментальних зразків напівпровідникових приладів і сенсорних систем нового покоління, а також ефективних перетворювачів сонячної енергії. Об'єкт дослідження – нові властивості матеріалів (із заданими фізичними параметрами), що були отримані для вирішення фундаментальних проблем фізики твердого тіла і які дозволяють створити нові нано- та оптоелектронні прилади з високою ефективністю. Мета роботи: розробити нові технології отримання напівпровідникових структур з подальшим створенням на їх основі сучасних приладів опто- і фотоелектроніки, мікро- і наноелектроніки, інфрачервоної та сенсорної техніки. Методи досліджень. Застосовувався комплексний підхід у використанні методів і засобів одержання напівпровідникових матеріалів і систем сучасної оптоелектроніки, мікро/наноелектроніки, інфрачервоної, сенсорної та інформаційної техніки. Були розвинуті та започатковані нові методи характеристикації та діагностики вказаних структур, зокрема, оптичні, акустичні, структурні і елементного аналізу, тощо. Наукова робота проводилась за чотирма взаємопов'язаними напрямками: Оптоелектроніка, сонячна енергетика та енергозберігаючі технології; Створення елементної бази НВЧ-, ТГц-, ІЧ-фотоелектроніки; Новітні сенсорні прилади та системи; Нові аналітичні методи контролю параметрів структур і матеріалів: Х-променеві та нанозондові методи. В процесі виконання роботи з використанням теоретичних моделей і експериментальних методів було отримано ряд науково-прикладних результатів, а саме: - Технологія виготовлення фотоматриці формату 1280x1024 з построкковим зчитуванням та множенням електронів (зареєстровано в МОН України № 0623U000106); - Технологія виготовлення кремнієвого лавинного фотодіода для ближньої інфрачервоної області спектру (зареєстровано в МОН України № 0623U000175); - Технологія отримання тонких ша

Реферат англійською:

The work was aimed at carrying out applied research in order to solve the current problems of modern semiconductor material science, namely for the manufacture and research of experimental samples of semiconductor devices and sensor systems of the new generation, as well as efficient solar energy converters. The object of research is new properties of materials (with specified physical parameters), which were obtained to solve fundamental problems of solid state physics and which will allow creating new nano- and optoelectronic devices with high efficiency. The purpose of the work is to develop new technologies for obtaining semiconductor structures with the further creation of modern devices of opto- and photoelectronics, micro- and nanoelectronics, infrared and sensor technology based on them. Research methods are the comprehensive approach which was applied in the use of methods and means of obtaining semiconductor materials and systems of modern optoelectronics, micro/nanoelectronics, infrared, sensor and information technology. New methods of characterization and diagnosis of the specified structures were developed and started, in particular, optical, acoustic, structural and elemental analysis, etc. Scientific work was carried out in four interrelated directions: 1. Optoelectronics, solar energy and energy-saving technologies; 2. Creation of an elementary base of microwave, THz, IR photoelectronics; 3. The latest sensor devices and systems; 4. New analytical methods of the parameters

controlling of structures and materials: X-ray and nanoprobe methods. In the process of work performing using theoretical models and experimental methods, a number of scientific and applied results were obtained, namely: - The technology of manufacturing of 1280x1024 photo array with line-by-line reading and electron multiplication (registered in the Ministry of Education and Culture of Ukraine No. 0623U000106); - The technology of obtaining the thin layers of highly porous nitrid

Індекс УДК: 621.315.562, 621.38.049.77, 621.315.592

Коди тематичних рубрик: 45.09.35, 47.33.33, 47.09.29

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Мельник Віктор Павлович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Технологія виготовлення фотоматриці формату 1280x1024 з построкowym зчитуванням та множенням електронів

Назва НТП англійською: The technology of manufacturing of 1280x1024 photo array with line-by-line reading and electron multiplication

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Технології

Галузь застосування: Виробництво інтегральних схем

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: 1. Комбінована технологія КМОН (компліментарна структура метал-оксид-напівпровідник) та ПЗЗ (прилади з зарядовим зв'язком), яка дає можливість отримати високу чутливість фотодіодів, низький рівень шуму скануючих ПЗЗ регістрів, високий рівень сигналу за рахунок множення електронів, низький рівень геометричного шуму. Використовується епітаксійна кремнієва пластина, 4 рівні полікристалічного кремнію, 2 рівня металізації, технологічні процеси КМОН та ПЗЗ.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Впровадження технології створить передумови для створення або модернізації приладів нічного бачення третього покоління

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2021

Закінчення етапу: 12.2023

Споживачі продукції: Виробники інтегральних схем

Перспективні ринки: Україна, Китай, країни ЄС, азійські та африканські країни

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Технологія отримання тонких шарів сильно поруватого нитридованого вуглецю методом ВЧ плазмового магнетронного осадження із газової фази для виготовлення газових сенсорів

Назва НТП англійською: The technology of obtaining the thin layers of highly porous nitrided carbon by the method of high frequency plasma magnetron deposition from the gas phase for the production of gas sensors

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Технології

Галузь застосування: Виробництво газових сенсорів

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Формування на поверхні кремнію сильно порушених шарів нітридованого вуглецю для подальшого виготовлення чутливих газових сенсорів, що працюють за кімнатних температур.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Технологія дозволяє виготовляти дешеві газові сенсори, зокрема на газоподібний аміак, що мають великий попит у галузі тваринництва, де потрібно контролювати дозволені концентрації аміачних сполук

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2021

Закінчення етапу: 12.2023

Споживачі продукції: Виробники газових сенсорів

Перспективні ринки: Україна, Китай, країни ЄС, азійські та африканські країни

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Технологія виготовлення багатоеlementних фоточутливих модулів на основі InSb для інфрачервоного діапазону довжин хвиль (2,5-5,5 мкм)

Назва НТП англійською: Manufacturing technology of the multi-element photosensitive modules based on InSb for the infrared range of wavelengths (2.5-5.5 μm)

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Технології

Галузь застосування: Приладобудування спеціального призначення

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Технологія базується на створенні серії InSb фоточутливих модулів для інфрачервоного діапазону довжин хвиль (2,5-5,5 мкм). Для цього використовуються пластини монокристалічного InSb n-типу

з концентрацією донорів $5 \cdot 10^{14}$ – $2 \cdot 10^{15}$ см⁻³. Корпусовані фотомодулі при робочих кріогенних температурах (80+20K), які мають інтегральну фоточутливість 0,7–1,0 А/В при опроміненні від абсолютно чорного тіла з температурою 500оK.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Вирішує проблему забезпечення вітчизняних виробників апаратури спеціального призначення високочутливими фотоприймальними модулями для ІЧ діапазону довжин хвиль

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2023

Закінчення етапу: 12.2023

Споживачі продукції: Виробники апаратури спеціального призначення

Перспективні ринки: Україна, Туреччина, Польща, Чехія, Індія

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Технологія виготовлення кремнієвого лавинного фотодіода для ближньої інфрачервоної області спектру

Назва НТП англійською: Manufacturing technology of the silicon avalanche photodiode for the near-infrared region of spectrum

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Технології

Галузь застосування: Приладобудування спеціального призначення

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Суть технології полягає в заміні високолегованої арсеном емітерної області осадженим високолегованим полікремнієвим шаром, що дозволяє зменшити концентрацію дефектів в області просторового заряду, а також зменшує паразитний вплив короткохвильового випромінювання, формування мета-поверхневого покриття у вигляді періодичних 1D/2D металічних ґраток для фокусування випромінювання на область лавинного помноження носіїв.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Дає можливість виробляти фотодіоди з високою чутливістю, низьким рівнем шуму, високим рівнем сигналу

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2022

Закінчення етапу: 12.2023

Споживачі продукції: Підприємства мікроелектронної галузі

Перспективні ринки: Україна, Туреччина, Польща, США, Індія

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

В результаті виконання роботи було опубліковано 154 наукові праці

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Мельник Віктор Павлович

д. ф.-м. н., 01.04.10

Перелік осіб-виконавців

Євменова Анна Зулхаїрівна

Євтух Анатолій Антонович

(д. ф.-м. н.)

Євтух Валерій Анатолійович

Єрмаков Валерій Миколайович

(к.ф.-м.н., 01.04.10)

Єрохін Сергій Юрійович

Єфанов Володимир Семенович

(к. ф.-м. н., 01.04.10)

Єфремов Олексій Олександрович

(к.ф.-м.н.)

Єшан Віктор Миколайович

Іваськевич Людмила Михайлівна

Індутний Іван Захарович

(д. ф.-м. н., 01.04.00)

Авксентьева Любов Вікторівна

Аленічев Володимир Дмитрович

Андросюк Ірина Григорівна

Андросюк Галина Миколаївна

Андрєєва Катерина Андріївна

Антонін Сергій Володимирович

Апатська Марія Вікторівна

Бекетов Геннадій Вікторович

(к. ф.-м. н., 01.04.07, 01.04.10)

Богословська Алла Борисівна

Бойко Ігор Іванович

(д. ф.-м. н.)

Болтовець Прасков'я Миколаївна

(к. б. н.)

Бондаренко Володимир Олександрович

(к.ф.-м.н.)

Борисенко Анатолій Андрійович

Борковська Людмила Володимирівна

(д. ф.-м. н., 01.04.07)

Борщагівський Євген Григорович

(д. ф.-м. н., 01.04.05)

Братусь Олег Леонідович

(к. ф.-м. н.)

Будзуляк Сергій Іванович

(к.ф.-м.н., 01.04.10)

Бунчук Світлана Григорівна

Бурлаченко Юлія Василівна

Беляєв Олександр Євгенович

(д. ф.-м. н., 01.04.10)

Вірко Сергій Валерійович

(к.ф.-м.н.)

Валах Михайло Якович

(д.ф.-м.н., 01.04.10, 1)

Васькова Ірина Костянтинівна

Васін Андрій Володимирович

(д. ф.-м. н., 01.04.07)

Велігура Людмила Іванівна

Венгер Євген Федорович

(д. ф.-м. н.)

Венгер Ірина Всеволодівна

Веремійченко Георгій Микитович

(к.т.н.)

Веровський Ігор Миколайович

Вихренко Олексій Григорович

Вихренко Тетяна Анатоліївна

Власюк Віктор Миколайович

(к. ф.-м. н., 01.04.10)

Войтович Марія Володимирівна

(к. ф.-м. н.)

Ворощенко Андрій Тарасович

Вуйчик Микола В"ячеславович

(к. ф.-м. н.)

Гаврилюк Євген Олегович

(к. ф.-м. н.)

Галушко Тетяна Олегівна

Генцарь Петро Олексійович

Герасименко Надія Вікторівна

Гнатюк Дмитро Володимирович

Голенков Олександр Генадійович

(к.ф.-м.н., 01.04.01)

Гоменюк Юрій Вікторович

(к.ф.-м.н., 01.04.07)

Гоменюк Юрій Юрійович

Горбанюк Тетяна Іванівна

(к. ф.-м. н.)

Грещук Олександр Михайлович

(к. ф.-м. н., 01.04.07)

Гринько Дмитро Олександрович

(к. т. н.)

Гриценко Костянтин Петрович

Гудзенко Ілля Ігорович

Гудзь Ольга Володимирівна

Гудименко Олександр Йосипович

(к.ф.-м.н.)

Гуле Євген Глібович

Гуменюк-Сичевська Жанна Віталіївна

(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Гурін Андрій Володимирович

Даниленко Ігор Миколайович

(аспірант)

Данько Віктор Андрійович

(д. ф.-м. н., 01.04.01)

Дверніков Борис Федорович

Деменський Олексій Миколайович

Демиденко Юрій Володимирович

(н.с.)

Демидов Петро Володимирович

(д.філософ)

Демчина Любомир Андрійович

(к. ф.-м. н., 01.04.10)

Джаган Володимир Миколайович

(д. ф.-м. н., 01.04.10)

Дикуша Валерій Миколайович

Дмитрук Надія Вікторівна

Дорошенко Тамара Павловна

Дремлюженко Ксенія Сергіївна

Дубіковський Олександр Володимирович

(к. ф.-м. н., 01.04.07)

Душейко Михайло Григорович

Дімітрієв Олег Петрович

(к. ф.-м. н., 01.04.07)

Жук Антон Геннадійович

(к.т.н., 01.04.07)

Журавель Людмила Василівна

Жученко Зоряна Ярославівна

Забудський Вячеслав Володимирович
(к.ф.-м.н., 01.04.10)

Зав'ялова Людмила Василівна
(к.т.н.)

Заяць Микола Сергійович

Заїченко Тетяна Михайлівна

Злобін Сергій Олександрович

Кабак Віктор Іванович

Калашник Юлія Юріївна

Калитчук Сергій Михайлович
(к. ф.-м. н., 01.04.10)

Камуз Олександр Михайлович
(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Капуш Ольга Анатоліївна
(к. х. н.)

Капшученко Наталія Миколаївна

Карачевцева Людмила Анатоліївна
(д.т.н., 05.27.06)

Кизяк Анатолій Юрійович
(к. ф.-м. н.)

Кислий Володимир Павлович
(к. ф.-м. н., 01.04.07)

Кисіль Дмитро Вадимович
(к. ф.-м. н.)

Кияк Юлія Петрівна

Кладько Василь Петрович
(д.ф.-м.н., 01.04.07)

Клюй Андрій Миколайович
(к. т. н., 05.27.06)

Клюй Микола Іванович
(д.ф.-м.н., 01.04.05)

Клімовська Алла Іванівна
(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Кліопа Світлана Теодорівна

Ковбаса Микола Юрійович

Козловський Сергій Іванович
(д. ф.-м. н., 01.04.10)

Козюба Михайло Михайлович

Колесніков Олександр Миколайович

Коломзаров Юрій Вікторович
(к. т. н.)

Коломис Олександр Федорович
(к. ф.-м. н.)

Колядіна Олена Юріївна

Кондратенко Ольга Сергіївна

Коптюх Анастасія Андріївна

Корбутяк Дмитро Васильович
(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Коркішко Роман Михайлович
(к. т. н.)

Корнага Василь Ігорович
(к.т.н.)

Корчовий Андрій Адамович
(к. ф.-м. н.)

Корінець Сергій Володимирович

Космін Анатолій Степанович

Костильов Віталій Петрович
(д. ф.-м. н., 01.04.01)

Костюкевич Катерина Вікторівна
(к.ф.-м.н., 01.04.01)

Костюкевич Сергій Олександрович
(к. ф.-м. н., 01.04.10)

Косуля Олександр Валерійович
(к. ф.-м. н.)

Косінов Олександр Генрихович
(к. ф.-м. н., 01.04.02)

Кріщенко Ірина Миронівна

Кравцов Валентин Анатолійович

Кравченко Сергій Олександрович
(к. т. н., 05.23.01)

Краснов Василь Олександрович
(к.т.н., 05.27.06)

Кретулis Володимир Станіславович

Кригіна Ніна Яківна

Крикунов Кирило Ігорович

Крицька Тетяна Володимирівна

Кругленко Іванна Василівна

Кукла Олександр Леонідович
(д. ф.-м. н., 01.04.01)

Кульбачинський Олександр Анатолійович

Кульчицький Богдан Нестерович

Куліш Микола Родіонович
(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Купріянова Олена Олександрівна

Купчак Ігор Мирославович

(к. ф.-м. н.)

Курчак Анатолій Іванович

(к. ф.-м. н.)

Кухтарук Наталія Іванівна

Кухтарук Сергій Миколайович

(к. ф.-м. н., 01.04.10)

Кушнерова Світлана Олексіївна

Левицький Сергій Миколайович

(к. т. н., 05.27.06)

Лисенко Володимир Сергійович

(д. ф.-м. н., 01.04.07)

Лисюк Ігор Олександрович

(к. ф.-м. н.)

Лисюк Віктор Олександрович

Литвин Віталій Костянтинович

(к. т. н.)

Литвин Петро Мар'янович

(к. ф.-м. н., 01.04.10)

Литвиненко Олег Олександрович

(к. ф.-м. н., 01.03.02)

Лобортас Людмила Євгенівна

Лозінський Володимир Борисович

(к.т.н., 05.27.06)

Локшин Михайло Маркович

(к.ф.-м.н.)

Лопатинський Андрій Миколайович

(к. ф.-м. н.)

Лоцько Олександр Павлович

(к. т. н.)

Лук'янов Анатолій Миколайович

(к.т.н.)

Любченко Олексій Ігорович

Лісовський Ігор Петрович

(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Мінакова Ірина Євгенівна

Мазур Назар Володимирович

(д.філософ, 105)

Максименко Зоя Василівна

(к. ф.-м. н.)

Маланич Галина Петрівна

(к. х. н., 01.04.18)

Мамикін Андрій Васильович

Мамикін Сергій Васильович

(к. ф.-м. н.)

Манойлов Едуард Геннадійович

Матвійчук Анатолій Васильович

Матвієнко Людмила Михайлівна

Матяш Ігор Євгенович

(к. ф.-м. н., 01.04.07)

Матійко Андрій Володимирович

Матіюк Іполит Миколайович

Мележик Євген Олександрович

(к. ф.-м. н.)

Минько Віктор Іванович

(к. ф.-м. н.)

Мотозюк Марія Лук'янівна

Мешкова Ірина Андріївна

Міняйло Анастасія Миколаївна

Міняйло Маргарита Антонівна

Ніколенко Андрій Сергійович

(к.ф.-м.н.)

Назаренкова Тетяна Іванівна

Назаров Олексій Миколайович

(д.ф.-м.н., 01.04.01)

Насека Віктор Миколайович

Оберемок Олександр Степанович

(к. ф.-м. н., 01.04.07)

Окулов Сергій Михайлович

Онищенко Володимир Федорович

Охолін Павло Миколайович

Павлюченко Олексій Сергійович

Папуша Василь Пантелейович

Паюк Олександр Петрович

(к. ф.-м. н., 01.04.00)

Педченко Юрій Миколайович

Пекар Григорій Соломонович

(д. ф.-м. н., 01.04.07)

Пекур Ілона Володимирівна

Пекур Демид Володимирович

Пляцко Сергій Володимирович

(к. ф.-м. н., 01.04.10)

Погода Валерій Іванович

Поліщук Юлія Олегівна

(к. ф.-м. н.)

Попов Валентин Георгійович

(к.ф.-м.н.)

Попович Михайло Васильович

Прокопенко Ігор Васильович

(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Проскурено Наталія Миколаївна

Рашковецький Любомир Васильович

Рева Володимир Павлович

(к. т. н.)

Рибалочка Андрій Володимирович

(к. т. н., 05.12.20)

Романюк Борис Миколайович

(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Руденко Тамара Охримівна

Рудько Галина Юріївна

(д. ф.-м. н., 01.04.10)

Русавський Андрій Вадимович

(к. ф.-м. н., 01.04.07)

Рябченко Олександр Віталійович

Сіднев Олександр Борисович

(к.ф.-м.н.)

Сіренко Олексій Олександрович

Савкіна Рада Костянтинівна

(д.ф.-м.н., 01.04.07)

Сапельнікова Олена Юріївна

Сапожинський Іван Євгенович

Сапон Сергій Васильович

Саріков Андрій Вікторович

(д. ф.-м. н., 01.04.07)

Саченко Анатолій Васильович

(д. т. н., 05.11.16)

Свеженцова Катерина Віталіївна

(к. ф.-м. н.)

Северіна Людмила Михайлівна

Северінова Ірина Дмитрівна

Семененко Микола Олександрович

(к. ф.-м. н.)

Семенюк Антон Сергійович

Серба Олександр Андрійович

Сизов Федір Федорович

(чл-кор. НАНУ)

Сингаївський Олександр Федорович

(к. ф.-м. н.)

Слободян Микола Васильович

Слободян Олександр Михайлович

(к.ф.-м.н., 14.03.01)

Слепкін Олексій Павлович

Слепова Олександра Станіславівна

Сліпокуров Віктор Сергійович

Смертенко Петро Семенович

(к.ф.-м.н., 01.04.10)

Смолій Марія Іванівна

Смірнов Олексій Борисович

(к. ф.-м. н., 01.04.07)

Снопок Борис Анатолійович

(д. ф.-м. н., 01.04.07)

Соколовський Ігор Олегович

Солнцев В'ячеслав Сергійович

(к. ф.-м. н.)

Сонько Тетяна Василівна

Сорокін Віктор Михайлович

(чл-кор. НАНУ)

Стадник Олександр Анатолійович

(к.ф.-м.н., 01.04.07)

Станіславський Анатолій Степанович

Стара Тетяна Русланівна

(к. ф.-м. н.)

Степанов Володимир Григорович

Стрельчук Віктор Васильвич

(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Стронський Олександр Володимирович

(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Стрільчук Оксана Миколаївна

(к. ф.-м. н.)

Суровцева Олена Ростиславівна

Тарасов Георгій Григорович

(д.ф.-м.н., 01.04.07)

Темченко Володимир Павлович

(к. т. н., 05.27.06)

Тетьоркін Володимир Володимир

(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Тетяненко Микола Петрович

Титаренко Павло Олександрович

Томашик Василь Миколайович

(д.х.н., 02.00.21)

Тріщук Любомир Іванович

(к. х. н., 01.04.18)

Тягульський Ігор Петрович

(к. ф.-м. н.)

Урицька Надія Ярославівна

Федоренко Леонід Леонідович

(д.ф.-м.н., 01.04.10)

Федоряк Олександр Миколайович

Федулов Віктор Васильович

(молодший науковий співробітник)

Федченко Олександр Миколайович

(01.04.01)

Хміль Денис Миколайович

Хоменкова Лариса Юріївна

(д.ф.-м.н., 01.04.07)

Хоперський Сергій Васильович

(-)

Цибрій Зіновія Федорівна

(д. ф.-м. н., 01.04.10)

Цибуленко Вадим Володимирович

Чапський Юрій Сергійович

Чегель Володимир Іванович

(д. ф.-м. н., 01.04.01)

Черненко Володимир Васильович

(к.ф.-м.н.)

Чорна Лариса Борисівна

Шаган Сергій Васильович

Шапар Володимир Миколайович

(01.04.07)

Шевчик-Шекера Анна Володимирівна

Шепелявий Петро Євгенович

(к. ф.-м. н.)

Шинкаренко Олена Вікторівна

(к. ф.-м. н., 01.04.10)

Шпортко Костянтин Валентинович

(д. ф.-м. н., 01.04.07)

Шугаєва Любов Михайлівна

Шутов Станіслав Вікторович

(к. т. н., 05.27.01)

Юхимчук Володимир Олександрович

(д.ф.-м.н., 01.04.10)

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

Назаренкова Т.І.

+38 (044) 525-40-20

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

